

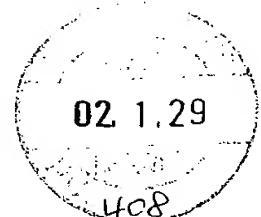
출력 일자: 2002/1/29

발송번호 : 9-5-2002-001829132
발송일자 : 2002.01.28
제출기일 : 2002.03.28

수신 : 서울 서초구 서초3동 1571-18 청화빌딩 2
층
이영필 귀하

137-874

특허청
의견제출통지서



출원인 명칭 삼성전자 주식회사 (출원인 코드: 119981042713)
주소 경기 수원시 팔달구 매탄3동 416

대리인 성명 이영필 외 2명
주소 서울 서초구 서초3동 1571-18 청화빌딩 2층

출원번호 10-2000-0035708

발명의 명칭 선택적 금속산화막 형성단계를 포함하는 반도체 소자의 제조방법 및 그 방법에 의하여 제조된 반도체 소자

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지합니다. 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서 또는/및 보정서를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 제1-20항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것으로 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

[아래]

1. 청구항 제1-14항의 '노출 유전막에 금속산화막을 형성하는 단계, 캐패시터 전표면을 감싸는 캡슐화막을 형성하는 단계를 갖는 /반도체 소자의 제조방법은/인용참증1(국내공개특허공보 제99-27321호 (1999.04.15))의 유전막의 측벽에 금속산화막을 형성하는 단계, 캐패시터 표면을 감싸는 캡핑층을 형성하는 단계를 갖는 반도체장치 제조방법 및/인용참증2(국내공개특허공보 제2000-25706호 (2000.05.06))의 금속산화막으로 제1캡슐화막을 형성하는 단계, 캐패시터 전표면을 감싸는 제2캡슐화막을 형성하는 단계를 갖는 반도체장치 제조방법 등에서 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.(특허법 제29조제2항)

2. 청구항 제15-20항의 유전막에 형성된 제1물성의 금속산화막과 상부전극 및 하부전극, 제1물성의 금속산화막 상에 형성된 제2물성의 금속산화막으로 이루어진 캡슐화막을 포함하는 반도체 소자는 인용참증1의 유전막의 측벽에 형성된 금속산화막(AI203 또는 Ti02)과 상부전극을 덮는 캡핑층(Ti02 또는 AI203)을 갖는 반도체장치 및 인용참증2의 제1금속산화막(AI203)으로 형성된 제1캡슐화막, 캐패시터 전표면을 감싸는 제2금속산화막(Ti02)로 이루어진 제2캡슐화막을 갖는 반도체장치 등에서 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.(특허법 제29조제2항)

[첨부]

첨부 1 인용참증1(국내공개특허공보 제99-27321호)
첨부2 인용참증2(국내공개특허공보 제2000-25706호) 끝.

0V14700

출력 일자: 2002/1/29

2002.01.28

특허청

심사4국

반도체2 심사담당관실

심사관 김근모



<<안내>>

문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5985 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터